

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛОКАЛІЗОВАНИХ СТАНІВ В ПРОСТОРОВО НЕГОМОГЕННИХ ЗРАЗКАХ МЕТОДОМ СТРУМІВ ОБМЕЖЕНИХ ПРОСТОРОВИМ ЗАРЯДОМ

М.М. Колесник, А.С. Опанасюк

Одержання інформації про основні параметри локалізованих станів (ЛС) у напівізольюючих матеріалах, їх глибину залягання та концентрацію, є актуальною науковою задачею, оскільки ці стани зумовлюють такі важливі характеристики матеріалу, як час життя носіїв заряду, їх довжину вільного пробігу та інше. У теперішній час з цією метою широкого використання набув метод, що заснований на аналізі вольт-амперних характеристик (ВАХ) струмів, обмежених просторовим зарядом (СОПЗ) [1]. Як правило при обробці ВАХ СОПЗ вважається, що просторовий розподіл ЛС у зразках є однорідним. Однак, це припущення не може бути використане для багатошарових структур, де на межі напівпровідник-метал в наслідок технологічних операцій можуть утворюватися перехідні шари з підвищеним вмістом точкових дефектів та поверхневі ЛС. Таким чином, просторова негомогенність плівок може суттєвим чином вплинути на вигляд ВАХ СОПЗ та привести до некоректності визначення параметрів ЛС у напівпровідникових шарах.

У зв'язку з цим, у роботі досліджена достовірність визначення концентрації та глибини залягання ЛС в неоднорідних зразках з ВАХ СОПЗ.

При дослідженні використовувалось наближення [2], яке припускало, що функція яка описує розподіл ЛС може бути розділена на дві частини, одна з яких залежить від енергії, а друга від просторової координати: $h(E, x) = h(E)S(x)$. Вважалося, що у зразку присутні

об'ємні та поверхневі стани, які локалізовані біля одного з електродів. Тоді просторовий розподіл пасток може бути заданий у вигляді $S(x) = S_0 + S_1 \exp(-x/r)$, або $S(x) = S_0 + S_1 \exp((x-L)/r)$, де S_0 – концентрація об'ємних, а S_1 – міжфазних станів, r – параметр просторового розподілу. Використовувалася наступна умова нормування: $S_0 + S_1 = 1$. Енергетичний розподіл ЛС описувався експоненціальною функцією.

Корегуючі коефіцієнти δ_1 та δ_2 , що враховують неоднорідність розподілу пасток за товщиною зразка розраховані із наступних співвідношень

$$\delta_1 = \frac{L}{L_{ef}} \left(\int_0^L S(x) dx / L_{ef} \right)^\beta,$$

$$\delta_2 = \left(\frac{L}{L_{ef}} \right)^2 \left(\int_0^L S(x) dx / L_{ef} \right)^{\beta-1},$$

де $\beta = 1 - \gamma$; L – дійсна; L_{ef} – ефективна товщина зразків; $\gamma = \frac{d^2 \lg U}{(d \lg I)^2}$ – нахил ВАХ у подвійних логарифмічних координатах.

Розрахунки корегуючих коефіцієнтів δ_1 та δ_2 для різних параметрів просторового розподілу пасток наведені на рис.

Встановлено, що неоднорідність розподілу пасток за товщиною зразка приводить до суттєвої зміни напруги повного заповнення пасток і відповідно похибок у визначенні дійсної концентрації ЛС. Шляхом моделювання показано, що якщо просторовий градієнт пасток не враховується, виникає систематичний зсув їх енергетичного положення,

який складає $-kTln\delta_1$, відповідно концентрація ЛС може бути завищеною або

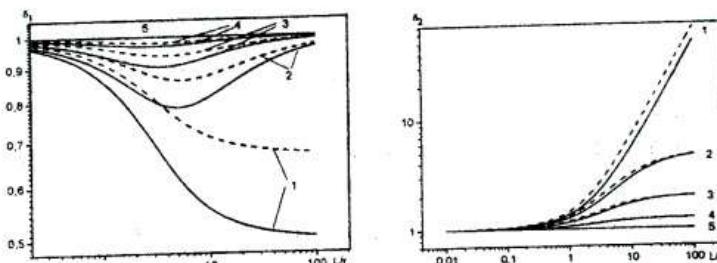


Рис. 1 – Залежність корегуючих коефіцієнтів δ_1 і δ_2 від співвідношення L/r для випадку максимуму ЛС на інжек- туючому електроді: 1 – $S_0=0$; 2 – $S_0=0,2$; 3 – $S_0=0,5$; 4 – $S_0=0,8$; 5 – $S_0=1$. Сплошні лінії – $\beta=1$, штрихові лінії – $\beta=0,5$.

заниженою у δ_2 разів. При цьому максимальна похибка визначення енергії пасток в неоднорідних зразках при ігноруванні неоднорідності не перевищує 15 %, в той же час похибка у визначенні їх концентрації може сягати 1-2 порядки за величиною.

Отримані результати показують, що густина ЛС одержаних з експериментальних ВАХ СОПЗ можуть бути перевірені або недооцінені як мінімум на декілька порядків по величині, але їх енергетичний профіль повинен бути принаймні схожим з дійсним.

- [1] В.О. Любчак, А.С. Опанасюк, Н.В. Тиркусова, В.І. Харченко Метод інжекційної спектроскопії для вивчення глибоких центрів у плівках телуриду кадмію // УФЖ – 1999 – Т.44, №6. – С. 741-747.
- [2] К. Као, В. Хуанг Перенос електронов в твердых телах: В 2 т.: Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – Т.1 Перенос электронов в твердых телах. – 352 с.